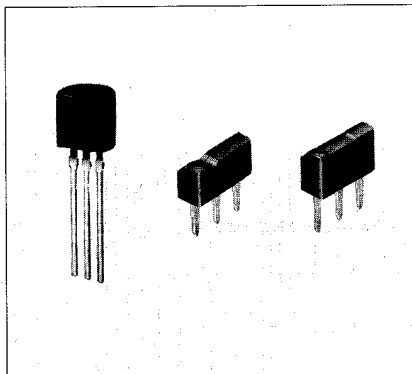


エピタキシャルプレーナ形 NPNシリコンダーリントントランジスタ

2SC1545 2SC1545M

2SC1645



当シリーズは、ダーリントン接続トランジスタで、数10mAから1.5Aまでの高い h_{FE} 増幅が可能です。

●特長

- 1) ダーリントン接続で高 h_{FE} である。
($h_{FE}=50000$ Typ. at 100mA)
- 2) BE間に約 $4k\Omega$ の抵抗を内蔵。
リーク電流の温度依存性も通常トランジスタと変わらない。
- 3) 熱暴走の危険性がない。

●用途

各種ソレノイドドライブ
各種LED
表示管ドライブ

●内部等価回路図

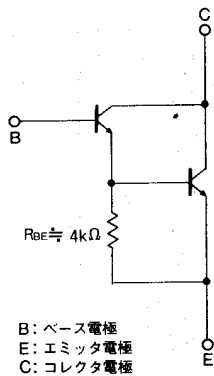


図4

●外形寸法図

2SC1645

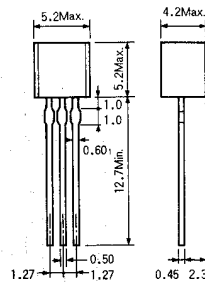


図1 JEDEC: T0-92
EIAJ: SC-43

2SC1545

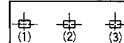
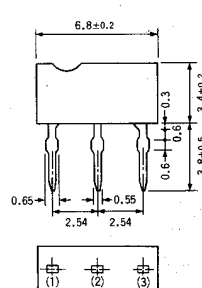
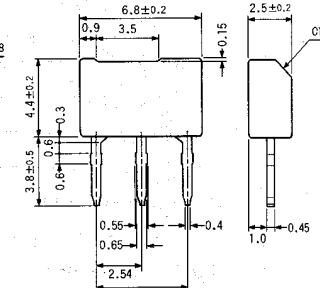


図2 FTR

2SC1545M



(単位: mm)

(1)エミッタ
(2)コレクタ
(3)ベース

図3 ATR

●絶対最大定格 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項 目	記 号	最大定格	単 位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CB0}	40	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CES}	32	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EB0}	6	V
コレクタ電流	I_C	300	mA
	I_C	1500*	mA (Pulse)
コレクタ損失	P_C	300	mW
接合部温度	T_j	125	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-55~125	$^\circ\text{C}$

* $P_w=10\text{ms}$, $\text{duty}=1/15$

●電気的特性 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項 目	記 号	Min	Typ	Max	単位	条 件
コレクタ・エミッタ降伏電圧	BV_{CES}	32	—	—	V	$I_C=1\text{mA}$, $R_{BE}=0$
コレクタ・ベース降伏電圧	BV_{CB0}	40	—	—	V	$I_C=100\mu\text{A}$
エミッタ・ベース降伏電圧	BV_{EB0}	6	—	—	V	$I_E=100\mu\text{A}$
コレクタしゃ断電流	I_{CB0}	—	—	1	μA	$V_{CB}=24\text{V}$
エミッタしゃ断電流	I_{EB0}	—	—	1	μA	$V_{EB}=4.5\text{V}$
直流電流増幅率	h_{FE}	1000	—	—	—	$V_{CE}/I_C=5\text{V}/100\text{mA}$ *
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	—	—	1.5	V	$I_C/I_B=200\text{mA}/0.4\text{mA}$
利得帯域幅積(トランジション周波数)	f_T	—	250	—	MHz	$V_{CE}=5\text{V}$, $I_E=-10\text{mA}$
コレクタ出力容量	C_{ob}	—	3	—	pF	$V_{CB}=10\text{V}$, $I_E=0$, $f=1\text{MHz}$

* バルス測定

h_{FE} の値により下表のように分類します。

アイテム	A	B
h_{FE}	1000以上	5000以上